**Magistrantūros Baigiamieji darbai:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vadovas (vadovo el. p., darbo tel. nr.) | Temos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis) | Trumpas temos aprašymas (lietuvių kalba ir anglų k.) | Tema laisva/  užimta |
| 1. | Dr. Vytautas Rumbauskas  vytautas.rumbauskas@ff.vu.lt  +370 5 223 4487 | Iškaitinimų nulemtų radiacinių defektų transformacijų tyrimas elektronais apšvitintuose Si pin dalelių jutikliuose  Anneal induced transforms of radiation defects in electron irradiated Si pin particle sensors | Studentas ištirs radiacinių defektų transformacijas ir elektrinių charakteristikų kaitą silicio dalelių sensoriuose, iškaitinimų poveikyje, pasitelkdamas I-V charakteristikų matavimo, bei PIS, DLTS spektroskopijų metodus. | Tema užimta |
| 2. | Dr. Žydrūnas Podlipskas ([zydrunas.podlipskas@ff.vu.lt](mailto:zydrunas.podlipskas@ff.vu.lt), [(8 5) 223 4467](tel:+37052234467)) | Laikinės skyros katodoliuminescencija InGaN junginių V-defektuoseTransient cathodoluminescence in InGaN V-defects | Darbo metu bus tiriami skirtingo dydžio V-defektai įvairios architektūros InGaN dariniuose pasitelkiant hibridinę katodoliuminescencijos / skenuojančią elektronų mikroskopiją su laikine skyra.  Darbo tikslas – nustatyti krūvininkų gyvavimo trukmių profilius skirtingo dydžio V-defektų aplinkoje, ir palyginti šiuos profilius tarp skirtingos architektūros InGaN darinių.  The topic will follow an investigation on various-size V-defects in InGaN structures of different architecture via time-resolved cathodoluminescence – scanning electron microscopy.  Study’s aim – to extract carrier lifetime profiles around V-defects of different size, and to compare them between InGaN structures of different architecture. | Tema užimta |